



深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

概述

DW02A/DW02B 系列电路是一款高精度的单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路, 它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。

正常状态下, DW02A/DW02B 的 VDD 端电压在过电压充电保护阈值 (V_{OC}) 和过电压放电保护阈值 (V_{OD}) 之间, 且其 V_M 检测端电压在充电器检测电压 (V_{CHG}) 与过电流放电保护阈值 (V_{EDI}) 之间, 此时 DW02A/DW02B 使内置 N-MOS 管导通。这时, 既可以使用充电器对电池充电, 也可以通过负载使电池放电。

DW02A/DW02B 通过检测 VDD 或 V_M 端电压 (相对于 GND 端) 来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时, 内置 N-MOS 由导通变为截止, 从而充/放电过程停止。

DW02A/DW02B 对每种保护状态都有相应的恢复条件, 当恢复条件满足以后, 内置 N-MOS 由截止变为导通, 从而进入正常状态。

DW02A/DW02B 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间, 只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除, 则不进入保护/恢复状态。

DW02A/DW02B 工作时功耗非常低, 采用非常小的 SOT23-5 的封装, 使得该芯片非常适合应用于空间限制小的可充电电池组应用。

本产品不适用与无线及射频信号排布及屏蔽太差的产品, 另请客户使用本产品前务必做成品整机验证。

特性

- 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 内置低导通内阻 N-MOSFET
- 高精度的过充电保护电压检测 $4.275V \pm 25mV$
- 高精度的过放保护电压检测 $2.425V \pm 75mV$
- 高精度过电流放电保护检测
- 电池短路保护
- 有 0V 充电
- 带有过充、过放自动恢复功能
- 内部集成 RC、内置 MOSFET (无需任何外围器件)
- 超小型化的 SOT23-5 封装
- MOSFET:RSS(on)<100mΩ (VGS=3.7V,ID=1A)

产品应用

- 锂电池的充电、放电保护电路
- 电话机电池或其它锂电池高精度保护器

订购信息

型号	封装形式	管脚数目	功能区别
DW02A	SOT23-5	5	过温保护带载可自恢复, 无需去除负载
DW02B	SOT23-5	5	过温保护带载不可恢复, 需去除负载

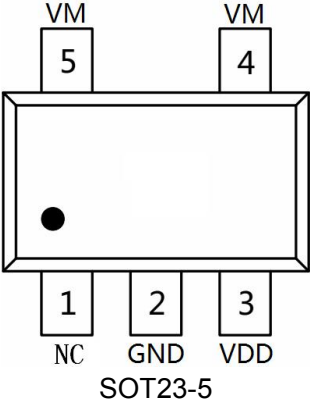


深圳市富满电子集团股份有限公司

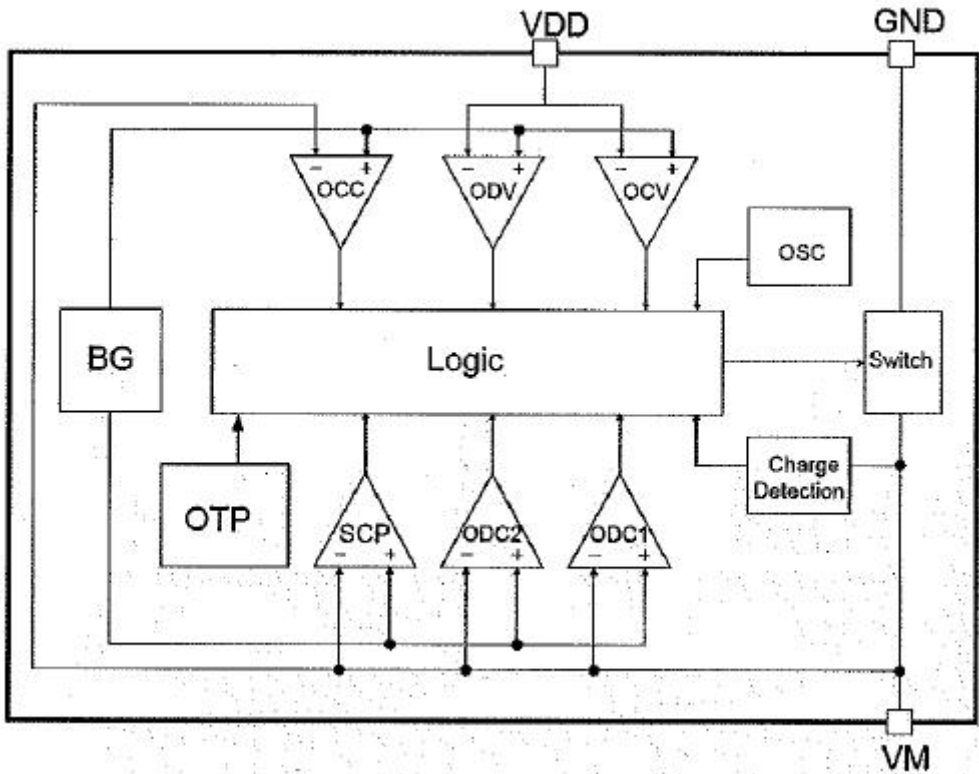
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号：S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

引脚示意图及说明

	序号	引脚名称	I/O	说明
	1	NC		空脚
	2	GND	POW	电源接地端，与供电电源（电池）的负极相连。
	3	VDD	POW	电源输入端，与供电电源（电池）的正极连接。
	4、5	VM	I	充/放电电流检测输入端

功能框图





深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

电压检测阈值及延迟时间

参数名称	DW02A/DW02B	精度范围
过电压充电保护阈值 VOCTYP	4.275V	±25mV
过电压充电恢复阈值 VOCRTYP	4.075V	±50mV
过电压放电保护阈值 VODTYP	2.425V	±75mV
过电压放电恢复阈值 VODRTYP	2.825V	±50mV
过电流放电保护阈值 VEDITYP	0.150V	±20mV
过电流充电保护阈值 VECITYP	-0.150V	±20mV
过电压充电保护延迟时间 tOCTYP	110ms	±30%
过电压放电保护延迟时间 tODTYP	55ms	±30%
过电流放电保护延迟时间 tEDITYP	7.0ms	±30%
过电流充电保护延迟时间 tECITYP	7.0ms	±30%
0V 充电功能	允许	
自动恢复功能	允许	

极限参数

参数	符号	数值	单位
VDD 供电电源	VDD	-0.3~+10	V
VM 端允许输入电压.	VM	VDD-6~VDD+0.3	V
工作温度	T _A	-40~+85	℃
结温		125	℃
贮存温度		-55~125	℃
功耗	PD (T _A =25℃)	500	mW
封装热阻	θ _{JA}	250	℃/W
焊接温度 (锡焊, 10 秒)		260	℃
防静电保护(人体模式)	ESD	4	kV

注: 超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围, 在这样的极限条件下工作, 器件的技术指标将得不到保证, 长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。



深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

电气参数(除非特别注明, 典型值的测试条件为: VDD = 3.6V, TA = 25℃。标注“■”的工作温度为: -40℃≤TA≤85℃)

参数名称	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
供电电源	V _{CC}		■	1.5		10	V
过电压充电保护阈值 (由低到高)	V _{OC}			V _{OCTYP} -0.025	V _{OCTYP}	V _{OCTYP} +0.025	V
			■	V _{OCTYP} -0.080	V _{OCTYP}	V _{OCTYP} +0.080	V
过电压充电恢复阈值 (由高到低)	V _{OCR}			V _{OCRTP} -0.050	V _{OCRTP}	V _{OCRTP} +0.050	V
			■	V _{OCRTP} -0.080	V _{OCRTP}	V _{OCRTP} +0.080	V
过电压充电保护延迟时间	t _{OC}	VCC=3.6V→4.5V		0.7×t _{OCTYP}	t _{OCTYP}	1.3×t _{OCTYP}	ms
过电压放电保护阈值 (由高到低)	V _{OD}			V _{ODTYP} -0.050	V _{ODTYP}	V _{ODTYP} +0.050	V
			■	V _{ODTYP} -0.105	V _{ODTYP}	V _{ODTYP} +0.105	V
过电压放电恢复阈值 (由低到高)	V _{ODR}			V _{ODRTY} -0.050	V _{ODRTYP}	V _{ODRTYP} +0.050	V
			■	V _{ODRTY} -0.105	V _{ODRTYP}	V _{ODRTYP} +0.105	V
过电压放电保护延迟时间	t _{OD}	VCC=3.6V→2.4V		0.7×t _{ODTYP}	t _{ODTYP}	1.3×t _{ODTYP}	ms
过电流放电保护阈值	V _{EDI}			V _{EDITYP} -0.020	V _{EDITYP}	V _{EDITYP} +0.020	V
持续带载电流	I _{lov}	VDD=3.5V			2.7		A
过放电电流检测	I _{lov}	VDD=3.5V			6.5		A
过电流放电保护延迟时间	t _{EDI}			0.7×t _{EDITYP}	T _{EDITYP}	1.3×t _{EDITYP}	ms
过电流放电恢复延迟时间	t _{EDIR}			1.20	1.80	2.40	ms
过电流充电保护阈值	V _{ECI}			V _{ECITYP} -0.020	V _{ECITYP}	V _{ECITYP} +0.020	V
过电流充电保护延迟时间	t _{ECI}			0.7×t _{ECITYP}	T _{ECITYP}	1.3×t _{ECITYP}	ms
过电流充电恢复延迟时间	t _{ECIR}			1.20	1.80	2.40	ms
负载短路保护阈值	V _{SHORT}	Voltage of VM		0.82	1.36	1.75	V
负载短路检测电流	I _{SHORT}	VDD=3.5V			20		A
充电器检测电压	V _{CHG}	VCC=3.0V		-0.27	-0.5	-0.86	V
电源电流	I _{CC}	VCC =3.9V			4.0	6.0	μA
0V 充电允许电压阈值	V _{0V_CHG}						

深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B

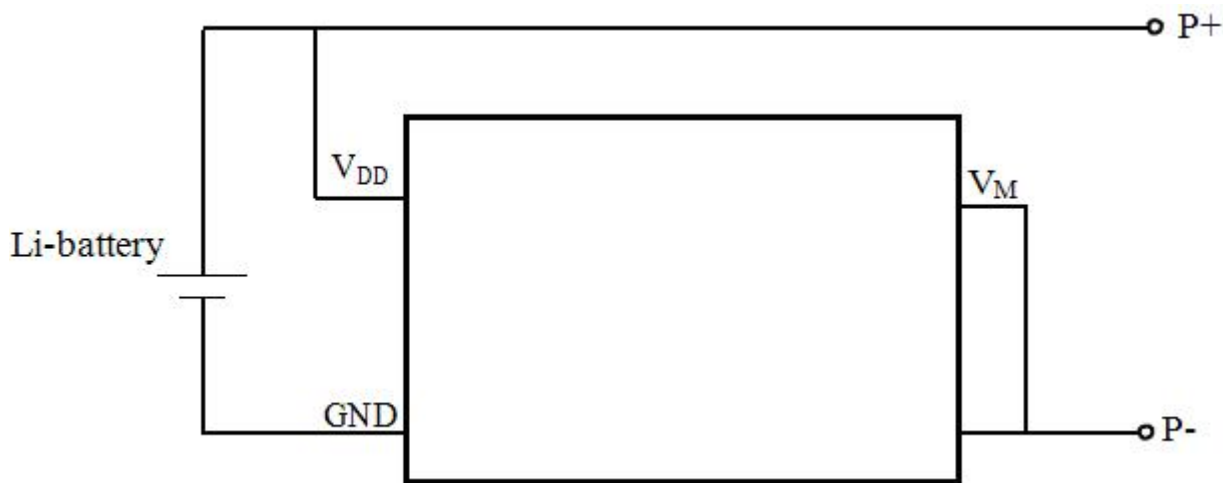
(文件编号: S&CIC1577)

高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

		Charger Voltage		1.2			V
过温保护						135	℃
过温保护恢复						110	℃
静态源-源极通态电阻 (VM 至 GND)	R _{SS(ON)}	VDD=3.7V, I _O =1A			80	100	mΩ

- 注：1. 除非特别说明，所有电压值均相对于 GND 而言
2. 参见应用线路图

典型应用电路图





深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) **高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路**

功能描述

DW02A/DW02B 是一款高精度的锂电池保护电路。正常状态下,如果对电池进行充电,则 DW02A/DW02B 可能会进入过电压充电保护状态;同时,满足一定条件后,又会恢复到正常状态。如果对电池放电,则可能会进入过电压放电保护状态或过电流放电保护状态;同时,满足一定条件后,也会恢复到正常状态。

正常状态

在正常状态下,DW02A/DW02B 由电池供电,其 VDD 端电压在过电压充电保护阈值 V_{OC} 和过电压放电保护阈值 V_{OD} 之间,VM 端电压在充电器检测电压 (V_{CHG}) 与过电流放电保护阈值 (V_{EDI}) 之间,内置 N-MOS 管导通。此时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。

过电压充电保护状态

➤ 保护条件

正常状态下,对电池进行充电,如果使 VDD 端电压 升高超过过电压充电保护阈值 V_{OC} ,且持续时间超过 过电压充电保护延迟时间 t_{OC} ,则 DW02A/DW02B 将使内置 N-MOS 管关闭,充电回路被“切断”,即 DW02A/DW02B 进入过电压充电保护状态。

➤ 恢复条件

有以下两种条件可以使 DW02A/DW02B 从过电压充电保护状态恢复到正常状态:

1) 电池由于“自放电”使 VDD 端电压低于过电压充电恢复阈值 V_{OCR} ;

2) 通过负载使电池放电(注意,此时虽然 内置 N-MOS 管 关闭,但由于其体内二极管的存在,使放电回路仍然存在),当 VDD 端电压低于过电压充电保护阈值 V_{OC} ,且 VM 端电压高于过电流放电保护阈值 V_{EDI} (在 内置 N-MOS 管 导通以前,VM 端电压将比 GND 端高一个二极管的导通压降)。

DW02A/DW02B 恢复到正常状态以后,内置 N-MOS 管回到导通状态。

过电压放电保护/低功耗状态

➤ 保护条件

正常状态下,如果电池放电使 VDD 端电压降低至过电压放电保护阈值 V_{OD} ,且持续时间超过过电压放电保护延迟时间 t_{OD} ,则 DW02A/DW02B 内置 N-MOS 管关闭,放电回路被“切断”,即 DW02A/DW02B 进入过电压放电保护状态。同时,VM 端电压将通过内部电阻 R_{VMD} 被上拉到 VDD。

➤ 恢复条件

当充电器连接上,并且 VM 电压低于充电器检测电压 V_{CHG} 时,电池电压升高到过电压放电保护阈值 V_{OD} 以上时,DW02A/DW02B 内置 N-MOS 管导通,芯片进入正常模式。如果 VM 电压不低于充电器检测电压 V_{CHG} ,那么电池电压升高到过电压放电恢复阈值 V_{ODR} 以上时,DW02A/DW02B 内置 N-MOS 管导通,芯片进入正常模式。

过电流放电/负载短路保护状态

➤ 保护条件

正常状态下,通过负载对电池放电,DW02A/DW02B 电路的 VM 端电压将随放电电流的增加而升高。如果放电电流增加使 VM 端电压超过过电流放电保护阈值 V_{EDI} ,且持续时间超过过电流放电保护延迟时间 t_{EDI} ,则 DW02A/DW02B 进入过电流放电保护状态;如果放电电流进一步增加使 VM 端电压超过电池短路保护阈值 V_{SHORT} ,且持续时间超过短路延迟时间 t_{SHORT} ,则 DW02A/DW02B 进入电池短路保护状态。



深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

DW02A/DW02B 处于过电流放电/负载电池短路保护状态时, 内置 N-MOS 管关闭, 放电回路被“切断”; 同时, VM 端将通过内部电阻 RVMS 连接到 GND, 放电负载取消后, VM 端电平即变为 GND 端电平。

➤ 恢复条件

在过电流放电/电池短路保护状态下, 当 VM 端电压由高降低至低于过电流放电保护阈值 V_{EDI} , 且持续时间超过过电流放电恢复延迟时间 t_{EDIR} , 则 DW02A/DW02B 可恢复到正常状态。因此, 在过电流放电/电池短路保护状态下, 当所有的放电负载取消后, DW02A/DW02B 即可“自恢复”。

DW02A/DW02B 恢复到正常状态以后, 内置 N-MOS 回到导通状态。

过电流充电保护状态

➤ 保护条件

正常状态下, 通过电源对电池充电, DW02A/DW02B 电路的 VM 端电压将随充电电流的增加而下降。如果充电电流增加使 VM 端电压超过过电流充电保护阈值 V_{ECI} , 且持续时间超过过电流充电保护延迟时间 t_{ECIR} , 则 DW02A/DW02B 进入过电流充电保护状态。

➤ 恢复条件

在过电流充电保护状态下, 当 VM 端电压由低升高至高于过电流充电保护阈值 V_{ECI} , 且持续时间超过过电流充电恢复延迟时间 t_{ECIR} , 则 DW02A/DW02B 可恢复到正常状态。

DW02A/DW02B 恢复到正常状态以后, 内置 N-MOS 回到导通状态。

0V 电池充电

➤ 0V 电池充电允许

对于 0V 电池充电允许的电路, 如果使用充电器对电池充电, 使 DW02A/DW02B 电路的 VDD 端相对 VM 端的电压大于 0V 充电允许阈值 V_{0V_CHG} 时, 则通过内置 N-MOS 管的体内二极管可以形成一个充电回路, 使电池电压升高; 当电池电压升高至使 VDD 端电压超过过电压放电保护阈值 V_{OD} 时, DW02A/DW02B 将回到正常状态, 同时内置 N-MOS 回到导通状态。

注: 当电池第一次接上保护电路时, 可能不会进入正常模式, 此时无法放电。如果产生这种现象, 使 VM 管脚电压等于 GND 电压 (将 VM 与 GND 短接) 或连接充电器, 就可以进入正常模式。



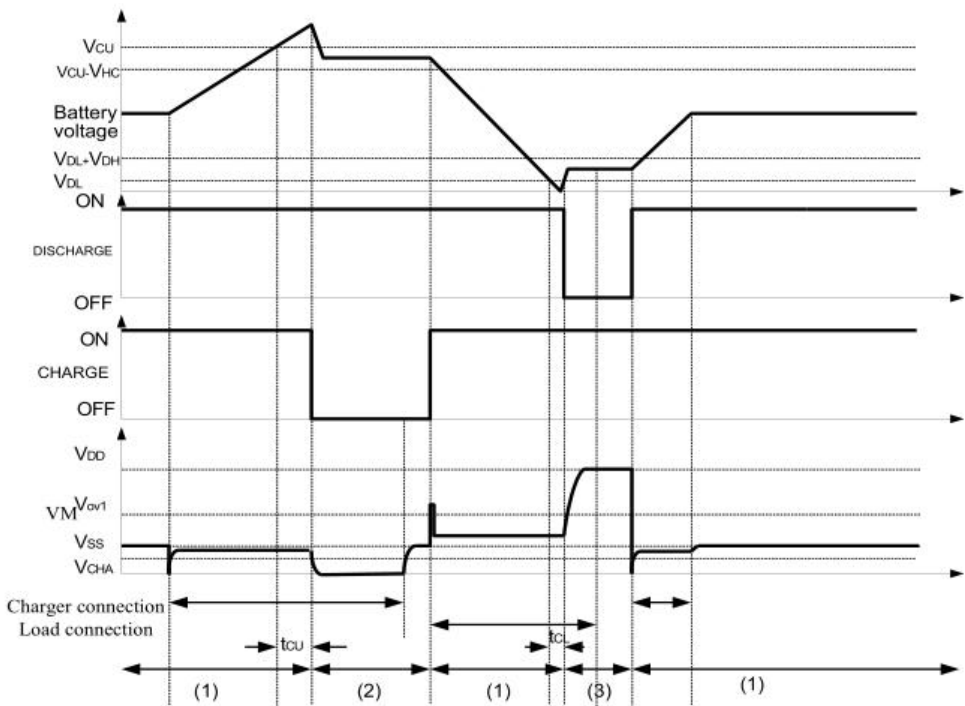
深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

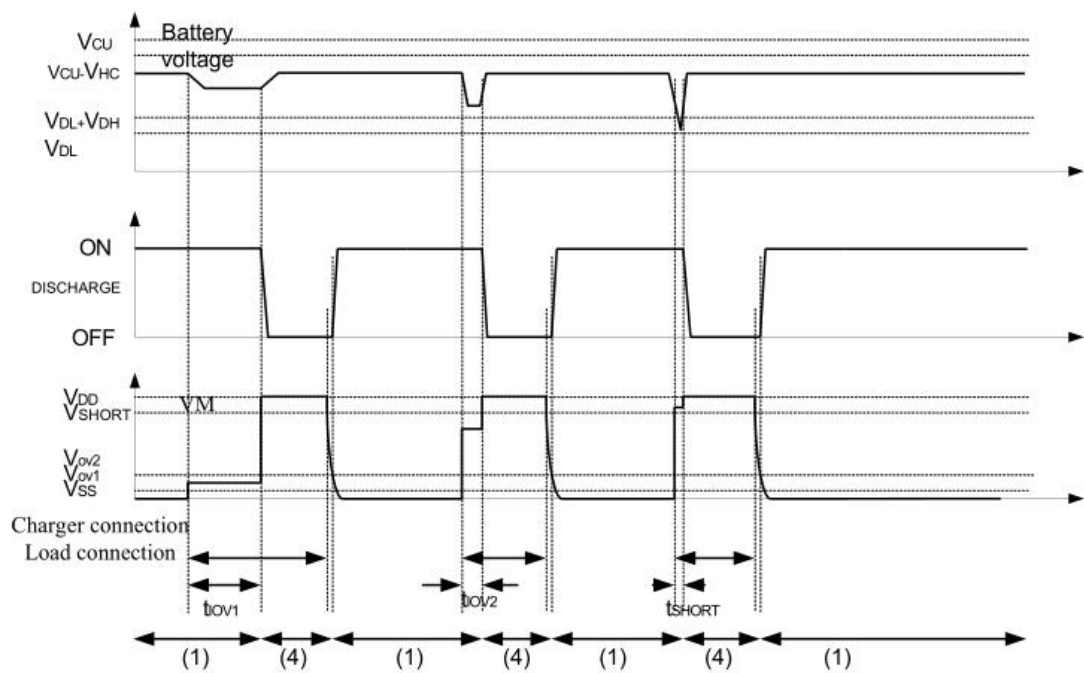
DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

状态转换波形图

➤ 过电压充电保护和过电压放电保护状态



➤ 过电流放电保护状态



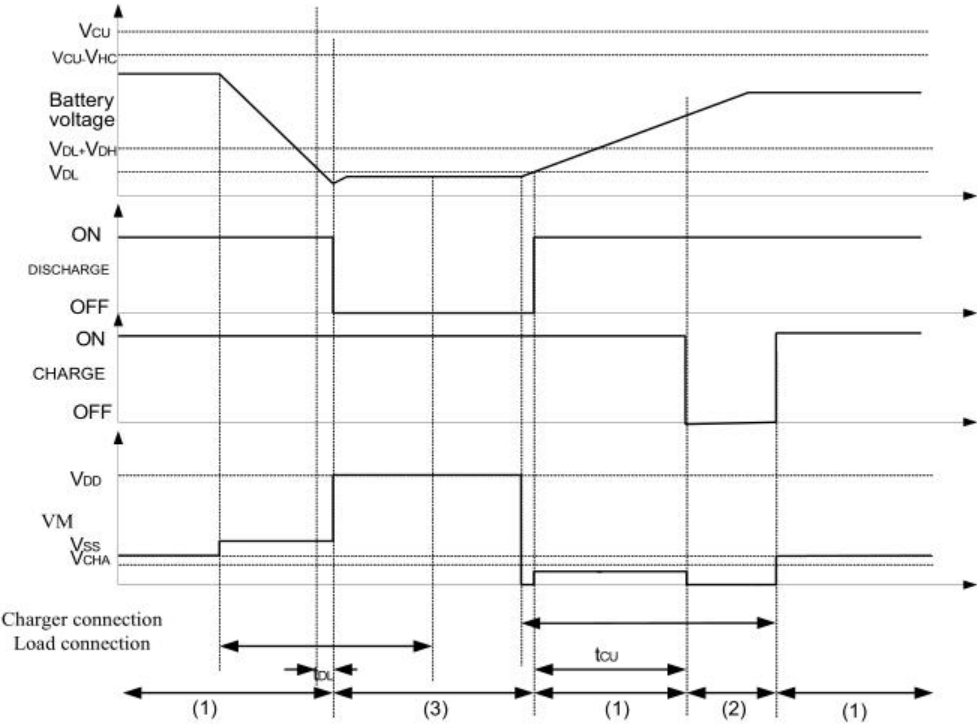


深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577) 高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

➤ 异常充电电流检测



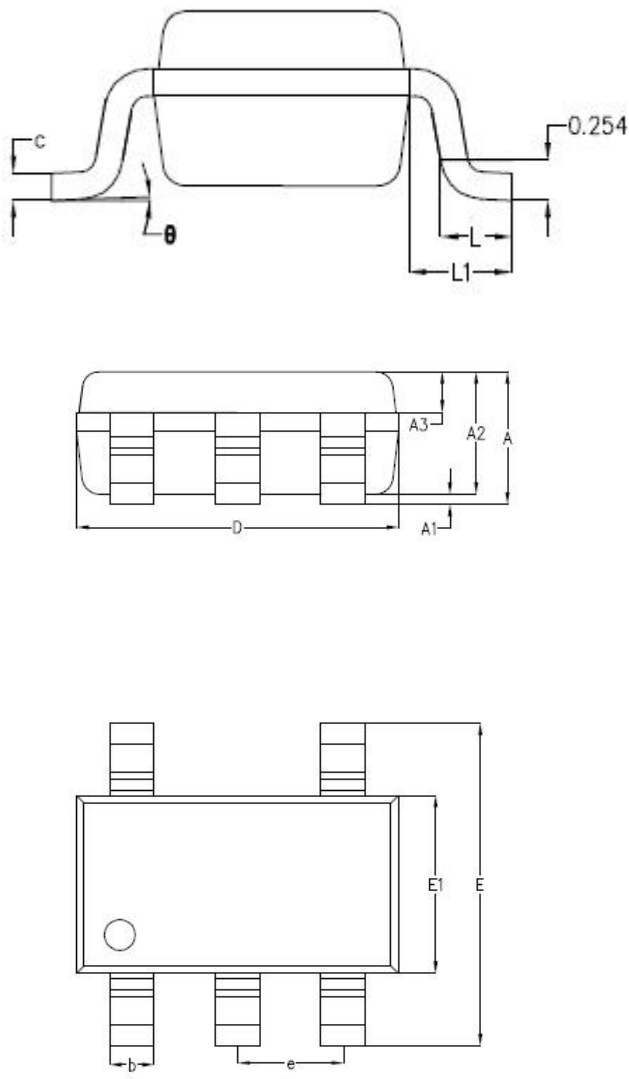
深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02A/DW02B(文件编号: S&CIC1577)高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

封装信息

➤ SOT23-5



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	1.19	1.24
A1	—	0.05	0.09
A2	1.05	1.10	1.15
A3	0.31	0.36	0.41
b	0.35	0.40	0.45
c	0.12	0.17	0.22
D	2.85	2.90	2.95
E	2.80	2.90	3.00
E1	1.55	1.60	1.65
e	0.95BSC		
L	0.37	0.45	0.53
L1	0.65BSC		
θ	0°	2°	8°